

Лазерная интерференционная холоэллипсометрия *in situ* с нормальным и брюстеровским отражениями света

© М. Али, Ю.Ю. Качурин, А.П. Кирьянов

МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, 105005, Россия

Рассмотрена холоэллипсометрия in situ с использованием лазерного интерференционного холоэллипсометра с бинарной модуляцией поляризации и нормальным и брюстеровским отражениями поляризованного света от одноосного двумерного кристалла, размещенного в плече интерферометра Майкельсона, который служит технической основой устройства.

Ключевые слова: эллипсометрия, интерферометр Майкельсона, бинарная модуляция поляризации, одноосный двумерный кристалл.

Эллипсометрия — перспективный метод реализации мониторинга двумерных кристаллов [1] при их синтезе и обработке в интересах создания материалов с необходимыми для практических целей свойствами. Благодаря контролю *in situ* квантового копирования циклов осаждения слоев атомов удастся обеспечить высокую точность и эффективность производства [2]. Физической основой мониторинга является исследование изменения состояния поляризации отраженного от кристалла светового потока при каждом цикле осаждения слоев.

Изменение состояния поляризации описывается относительным комплексным амплитудным коэффициентом отражения ρ^* , равным отношению комплексных амплитудных коэффициентов отражения r_p^* и r_s^* для составляющих потока излучения с линейными *p*- и *s*-поляризациями [3]:

$$\rho^* = \frac{r_p^*}{r_s^*} = \frac{r_p}{r_s} \exp\{i(\delta_p - \delta_s)\} = \operatorname{tg} \Psi \exp\{i \Delta\},$$

где $r_p^* = r_p \exp\{i\delta_p\}$; $r_s^* = r_s \exp\{i\delta_s\}$; r_p , r_s — модули; δ_p , δ_s — аргументы коэффициентов r_p^* и r_s^* [3].

Соотношения

$$\begin{aligned} \operatorname{tg} \Psi &= \frac{r_p}{r_s}; \\ \Delta &= \delta_p - \delta_s \end{aligned} \tag{1}$$

являются основными эллипсометрическими параметрами образца [3]. Методы двухпараметричности эллипсометрии (1) применяют только для контроля прозрачных изотропных образцов, определяя всего два его параметра: как правило, толщину и показатель преломления.

Для определения бóльшего количества параметров служат методы холоэллипсометрии. С их помощью измеряют в режиме *in situ* основные эллипсометрические параметры при различных углах падения одновременно, что позволяет контролировать более сложные объекты, например двумерные кристаллы [4].

Функциональная схема лазерного интерференционного холоэллипсометра *in situ* приведена на рис. 1. Оптическая схема представленного прибора основана на интерферометре Майкельсона, в котором используется нормальное и брьюстеровское падение света на образец S , помещенный в так называемое рабочее плечо интерферометра.

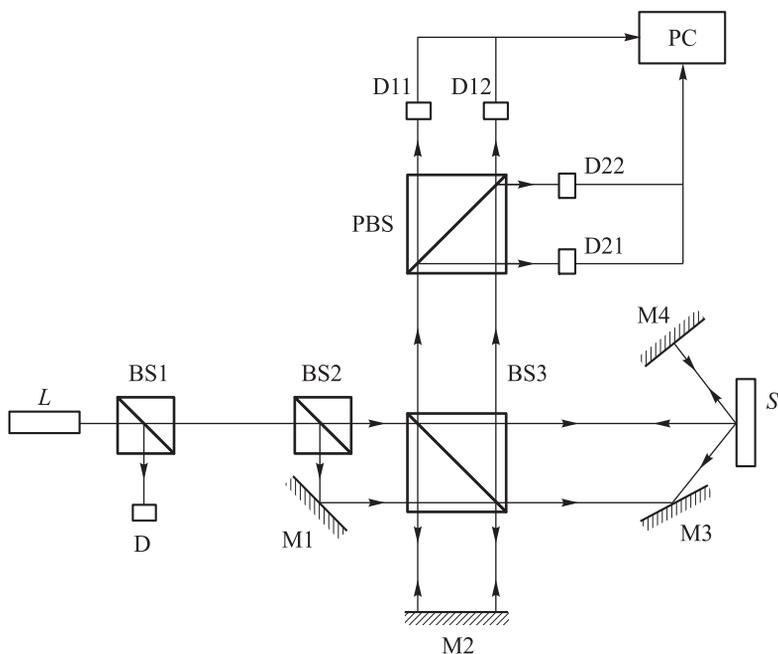


Рис. 1. Схема лазерного интерференционного холоэллипсометра *in situ*

Источник излучения — лазер L создает поток линейно поляризованного света, который через светоделители BS1 и BS2 попадает в интерферометрическую часть холоэллипсометра, состоящую из светоделителя BS3, зеркал M2, M3, M4 и образца S . Поток света, отраженный светоделителем BS3, нормально падает на зеркало M2 и отражается им, формируя опорный поток света. Излучение, прошедшее через светоделитель BS3, попадает в рабочую ветвь интерферометра, испытывая нормальное отражение от образца S . Кроме того, за счет

отражения светоделителем BS2 и зеркалами M1, M3 и M4 формируется второй рабочий поток света, падающий на образец S под углом Брюстера. Благодаря нормальному падению света на зеркало M4 обеспечивается его реверс. При нормальном падении света зеркала M2 и M4 работают как идеальные изотропные отражатели, не изменяющие поляризацию падающего на них света.

Потоки света из рабочей и опорной ветвей холоэллипсометра соединяются в светоделителе BS3 и попадают в канал регистрации, которую осуществляют поляризационным светоделителем PBS и четырьмя фотоприемниками D11, D12 и D21, D22. Светоделитель PBS служит для разделения ортогональных составляющих, поляризованных в плоскости падения на светоделительную грань светоделителя BS3 и перпендикулярно ей.

Фотоприемники D11, D12, D21, D22 преобразуют поступающее на них излучение в электрические сигналы, которые подвергаются обработке (усилению, синхродетектированию, оцифровке и т. п.) в блоке обработки и отображения информации РС.

Получаемые с выходов фотоприемников D11, D12, D21, D22 электрические сигналы $I_{uv}(\Delta S)$ ($u, v = 1, 2$) являются, в общем случае, функциями оптической разности хода ΔS в опорной и рабочей ветвях интерферометрической части холоэллипсометра. В зависимости от времени t оптическую разность хода ΔS можно представить суммой двух слагаемых — фиксированной Δ_{const} и переменной Δ_{var} :

$$\Delta S = \Delta_{\text{const}} + \Delta_{\text{var}} = \Delta_0 + \delta\Delta_m \sin(2\pi\Omega t), \quad (2)$$

где $\delta\Delta_m$ — амплитуда; Ω — частота модуляции.

Таким образом, переменная составляющая определяет глубину и скорость фазовой модуляции.

Изменение оптической разности хода ΔS в интерферометрической части холоэллипсометра выполняют возвратно-поступательным перемещением зеркала M2 рабочей ветви за счет линейного актуатора LA, управляющее напряжение для которого формируется в блоке обработки и отображения информации РС.

Влияние флуктуаций мощности излучения лазера ослабляют тем, что сигналы с фотоприемников D11, D12, D21, D22 нормируют сигналом с фотоприемника D, который регистрирует излучение, отраженное от BS1.

Развиваемый в работе метод базируется на использовании формального аппарата векторов и матриц Джонса [3], позволяющего рассчитать комплексную амплитуду E электрического вектора на выходе оптической системы на основе известной информации о комплексной амплитуде электрического вектора волны на входе оптической си-

стемы и поляризационных свойствах всех отдельных оптических элементов на пути ее распространения.

Зададим систему координат, направив ось z по направлению падающего луча, ось x — в плоскости падения луча на светоделительную грань светоделителя BS, ось y — перпендикулярно плоскости падения так, что оси координат образуют правую тройку векторов.

Пусть E_{ip} и E_{is} — составляющие вектора E_i в плоскости падения (p -) на светоделительную грань светоделителя BS3 и перпендикулярно ей (s -). Тогда вектор Джонса потока света на входе интерферометрической части имеет вид

$$E_i = \begin{bmatrix} E_{ip} \\ E_{is} \end{bmatrix}.$$

Светоделители BS1 и BS2, зеркало M1 расположены до интерферометрической части холоэллипсометра и их поляризационные свойства можно не учитывать.

Поляризационное действие светоделителя BS3 связано с анизотропией амплитудных коэффициентов отражения r_p^* , r_s^* и пропускания t_p^* , t_s^* светоделительного покрытия для компонент потока света с линейными p - и s -поляризациями. В общем случае коэффициенты отражения и пропускания имеют комплексный вид:

$$\begin{aligned} r_p^* &= r_p \exp\{i \varphi_{rp}\}; & r_s^* &= r_s \exp\{i \varphi_{rs}\}; \\ t_p^* &= t_p \exp\{i \varphi_{tp}\}; & t_s^* &= t_s \exp\{i \varphi_{ts}\}. \end{aligned}$$

Образец представляет собой одноосный двумерный кристалл, оптическая ось ζ которого параллельна границе раздела (рис. 2). При входе в среду такого кристалла нормально падающая световая волна разделяется на две линейно поляризованные волны с ортогональными поляризациями — обыкновенную и необыкновенную. Они распространяются в одном и том же направлении, но с различными скоростями, зависящими от показателей преломления n_o и n_e .

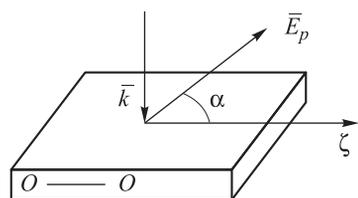


Рис. 2. Одноосный контролируемый образец:

\bar{k} — волновой вектор падающей волны

Поляризационные свойства образца будем описывать комплексными амплитудными коэффициентами r_{ζ}^* и r_{η}^* отражения, связанными с компонентами потока света, которые поляризованы соответственно вдоль и поперек оптической оси ζ кристалла:

$$r_{\zeta}^* = r_{\zeta} \exp\{i \varphi_{\zeta}\}; \quad r_{\eta}^* = r_{\eta} \exp\{i \varphi_{\eta}\}.$$

Они представляют собой функции соответственно обыкновенного n_o и необыкновенного n_e показателей преломления и толщины d образца, а образец действует как низкодобротный интерферометр Фабри — Перо.

Пусть оптическая ось кристалла ζ составляет угол α с направлением p -поляризации потока света на светоделителе BS3 (см. рис. 2), тогда комплексные амплитуды электрических векторов из опорной E_1 и рабочей E_2 ветвей интерферометрической части холоэллипсометра принимают вид

$$E_1 = \begin{bmatrix} E_{1p} \\ E_{1s} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_{ip} t_p^* r_p^* \\ E_{is} t_s^* r_s^* \end{bmatrix}; \quad (3)$$

$$E_2 = \begin{bmatrix} E_{2p} \\ E_{2s} \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} E_{ip} r_p^* t_p^* (r_{\zeta}^* \cos^2 \alpha + r_{\eta}^* \sin^2 \alpha) + E_{is} r_p^* t_s^* (r_{\zeta}^* - r_{\eta}^*) \sin \alpha \cos \alpha \\ E_{is} r_s^* t_s^* (r_{\zeta}^* \sin^2 \alpha + r_{\eta}^* \cos^2 \alpha) + E_{ip} r_s^* t_p^* (r_{\zeta}^* - r_{\eta}^*) \sin \alpha \cos \alpha \end{bmatrix}. \quad (4)$$

Комплексная амплитуда суммарной волны после светоделителя BS3 равна сумме комплексных амплитуд из опорной E_1 и рабочей E_2 ветвей:

$$E_{\Sigma} = E_1 + E_2 = \begin{bmatrix} E_{\Sigma p} \\ E_{\Sigma s} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_{1p} \exp(i \varphi_1) + E_{2p} \exp(i \varphi_2) \\ E_{1s} \exp(i \varphi_1) + E_{2s} \exp(i \varphi_2) \end{bmatrix}, \quad (5)$$

где φ_1 и φ_2 — набеги фаз волн при их распространении в опорной и рабочей ветвях интерферометрической части.

Регистрируемые фотоприемниками D11 и D12 интенсивности связаны с комплексными амплитудами (5) выражениями

$$I_{\Sigma p} = E_{\Sigma p} E_{\Sigma p}^* = I_p^{\text{фон}} + \Delta I_p (\Delta \varphi); \quad (6)$$

$$I_{\Sigma s} = E_{\Sigma s} E_{\Sigma s}^* = I_s^{\text{фон}} + \Delta I_s (\Delta \varphi) \quad (7)$$

и представляют собой функцию разности фаз $\Delta \varphi = \varphi_1 - \varphi_2$, которая связана с оптической разностью хода (2) соотношением

$$\Delta \varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta S = \frac{2\pi}{\lambda} (\Delta_0 + \Delta_{\text{var}}) = \Delta \varphi_0 + \Delta \varphi_m \sin(2\pi \Omega t). \quad (8)$$

Подставляя выражения (2)–(5) в соотношения (6) и (7), получаем переменные составляющие интенсивности $\Delta I_p(\Delta\varphi)$ и $\Delta I_s(\Delta\varphi)$ на фотоприемниках D11 и D12:

$$\Delta I_p(\Delta\varphi) = 2(E_{ip}^2 t_p^2 r_p^2) G_p; \quad (9)$$

$$\Delta I_s(\Delta\varphi) = 2(E_{is}^2 t_s^2 r_s^2) G_s, \quad (10)$$

где

$$G_p = r_\zeta \cos^2 \alpha \cos(\Delta\varphi - \varphi_\zeta) + r_\eta \sin^2 \alpha (\Delta\varphi - \varphi_\eta) + (q/2) \sin 2\alpha \left[r_\zeta \cos(\Delta\varphi - \varphi_\zeta + \Delta\varphi_{ps}) - r_\eta \cos(\Delta\varphi - \varphi_\eta + \Delta\varphi_{ps}) \right];$$

$$G_s = r_\zeta \sin^2 \alpha \cos(\Delta\varphi - \varphi_\zeta) + r_\eta \cos^2 \alpha (\Delta\varphi - \varphi_\eta) + (1/2q) \sin 2\alpha \left[r_\zeta \cos(\Delta\varphi - \varphi_\zeta + \Delta\varphi_{ps}) - r_\eta \cos(\Delta\varphi - \varphi_\eta + \Delta\varphi_{ps}) \right];$$

$$q = \frac{E_{is} t_s}{E_{ip} t_p}; \quad \Delta\varphi_{ps} = \varphi_{ip} - \varphi_{is}.$$

Аналогично можно получить выражения для переменных составляющих интенсивности $\Delta I_p^{\text{ЭГ}}(\Delta\varphi)$ и $\Delta I_s^{\text{ЭГ}}(\Delta\varphi)$ в случае нормального отражения излучения эталоном, установленным на месте образца S в рабочей ветви интерферометра:

$$\Delta I_p^{\text{ЭГ}}(\Delta\varphi) = 2E_p^2 t_p^2 r_p^2 \cos \Delta\varphi; \quad (11)$$

$$\Delta I_s^{\text{ЭГ}}(\Delta\varphi) = 2E_s^2 t_s^2 r_s^2 \cos \Delta\varphi. \quad (12)$$

Зависимости (9) и (10) для образца S и (11) и (12) для эталона нормируют, деля их на интенсивность I_0 излучения на входе холоэлементметра, и приводят к так называемым нормированным сигналам $\Delta i_p(\Delta\varphi)$, $\Delta i_s(\Delta\varphi)$, $\Delta i_p^{\text{ЭГ}}(\Delta\varphi)$, $\Delta i_s^{\text{ЭГ}}(\Delta\varphi)$ вида

$$\Delta i_p(\Delta\varphi) = \frac{\Delta I_p(\Delta\varphi)}{I_0}; \quad \Delta i_s(\Delta\varphi) = \frac{\Delta I_s(\Delta\varphi)}{I_0}; \quad (13)$$

$$\Delta i_p^{\text{ЭГ}}(\Delta\varphi) = \frac{\Delta I_p^{\text{ЭГ}}(\Delta\varphi)}{I_0}; \quad \Delta i_s^{\text{ЭГ}}(\Delta\varphi) = \frac{\Delta I_s^{\text{ЭГ}}(\Delta\varphi)}{I_0}. \quad (14)$$

Деление нормированных сигналов $\Delta i_{(p,s)}(\Delta\varphi)$ (13) для образца S на соответствующие амплитуды нормированных сигналов $\Delta i_{(p,s)}^{\text{ЭГ}}(\Delta\varphi)$

(14) для эталона позволяет получить универсальные соотношения для приведенных нормированных сигналов от образца S в виде

$$\Delta i_p^{\text{np}}(\Delta\varphi) = \left[r_\zeta \cos^2 \alpha \cos(\Delta\varphi - \varphi_\zeta) + r_\eta \sin^2 \alpha (\Delta\varphi - \varphi_\eta) \right] + (q/2) \sin 2\alpha \left[r_\zeta \cos(\Delta\varphi - \varphi_\zeta + \Delta\varphi_{ps}) - r_\eta \cos(\Delta\varphi - \varphi_\eta + \Delta\varphi_{ps}) \right]; \quad (15)$$

$$\Delta i_s^{\text{np}}(\Delta\varphi_t) = \left[r_\zeta \sin^2 \alpha \cos(\Delta\varphi - \varphi_\zeta) + r_\eta \cos^2 \alpha (\Delta\varphi - \varphi_\eta) \right] + (1/2q) \sin 2\alpha \left[r_\zeta \cos(\Delta\varphi - \varphi_\zeta - \Delta\varphi_{ps}) - r_\eta \cos(\Delta\varphi - \varphi_\eta - \Delta\varphi_{ps}) \right]. \quad (16)$$

Сумма $\Delta i^{\text{np}}(\Delta\varphi) = \Delta i_p^{\text{np}}(\Delta\varphi) + \Delta i_s^{\text{np}}(\Delta\varphi)$ приведенных нормированных сигналов для p - и s -поляризаций (15) и (16) есть линейная функция аргумента $\sin 2\alpha$:

$$\Delta i^{\text{np}}(\Delta\varphi) = A + B \sin 2\alpha, \quad (17)$$

где A и B — коэффициенты пропорциональности, зависящие от $\Delta\varphi$.

Производная от выражения (17) по азимуту α позволяет найти положение его экстремума $\alpha_{\text{экс}}$ и, следовательно, нулевого азимута ($\alpha = 0$). Выражения (15) и (16) при совмещении направлений оптической оси ζ двумерного кристалла и собственной линейной p -поляризации светоделителя BS3 (при азимуте $\alpha = 0$) существенно упрощаются:

$$\Delta i_{(p,s)}^{\text{np}}(\Delta\varphi) = r_{(\zeta,\eta)} \cos \left[\Delta\varphi - \varphi_{(\zeta,\eta)} \right]. \quad (18)$$

Фазовая модуляция интенсивности излучения (8) на частоте Ω в опорном плече интерферометра (см. рис. 1) трансформирует соотношения (18) к виду

$$\Delta i_{(p,s)}^{\text{np}}(\Delta\varphi_0) = r_{(\zeta,\eta)} \cos \left[\Delta\varphi_0 - \varphi_{(\zeta,\eta)} \right]. \quad (19)$$

Синусное S^F и косинусное C^F фурье-преобразования приведенных нормированных сигналов $\Delta i(\Delta\varphi_0)$ (19) дают искомые S^F - и C^F -фурье-образы полного комплексного фурье-преобразования [5]:

$$S^F \left[\Delta i_{(p,s)}^{\text{np}}(\Delta\varphi_0) \right] = r_{(\zeta,\eta)} \cos \varphi_{(\zeta,\eta)}; \quad (20)$$

$$C^F \left[\Delta i_{(p,s)}^{\text{np}}(\Delta\varphi_0) \right] = r_{(\zeta,\eta)} \sin \varphi_{(\zeta,\eta)}. \quad (21)$$

Фурье-образы (20) и (21), получаемые в результате математической обработки экспериментальных данных при наличии фазовой модуляции (8), позволяют найти как модули $r_{(\zeta,\eta)}$, так и значения $\operatorname{tg} x$ по аргументу $x = \varphi_{(\zeta,\eta)}$ комплексных амплитудных коэффициентов отражения $r_{(\zeta,\eta)}^*$ при нормальном отражении потока света образцом одноосного двумерного кристалла:

$$r_{(\zeta,\eta)} = \left[\left(S^F \left[\Delta i_{(p,s)}^{\text{np}} (\Delta \varphi_0) \right] \right)^2 + \left(C^F \left[\Delta i_{(p,s)}^{\text{np}} (\Delta \varphi_0) \right] \right)^2 \right]^{1/2};$$

$$\operatorname{tg} \varphi_{(\zeta,\eta)} = \frac{C^F \left[\Delta i_{(p,s)}^{\text{np}} (\Delta \varphi_0) \right]}{S^F \left[\Delta i_{(p,s)}^{\text{np}} (\Delta \varphi_0) \right]}.$$
(22)

При параллельном использовании с нормальным отражением брюстеровского отражения составляющих лазерного излучения можно вдвое расширить набор экспериментально определяемых *in situ* холоэллипсометрических параметров оптически одноосных двумерных кристаллов.

Сонаправленность оптической оси ζ двумерного кристалла и линейной p -поляризации потока света на светоделителе BS3 позволяет практически аналогично воспользоваться предшествующими результатами и для наклонного падения света на образец, в частности под углом Брюстера $\Theta_{\text{Бр}}$. При этом изменения p - и s -составляющих электрического вектора, падающего на образец S , коррелирующими с линейными ζ - и η -поляризациями необыкновенной и обыкновенной световой волны в среде оптически одноосного двумерного кристалла, описываются формулами Френеля для комплексных амплитудных коэффициентов отражения $r_{(p,s)\text{Бр}}^*$ в виде [3, 4]

$$r_{p.\text{Бр}}^* = \frac{\operatorname{tg}(\Theta_{\text{Бр}} - \Theta_1)}{\operatorname{tg}(\Theta_{\text{Бр}} + \Theta_1)};$$

$$r_{s.\text{Бр}}^* = -\frac{\sin(\Theta_{\text{Бр}} - \Theta_1)}{\sin(\Theta_{\text{Бр}} + \Theta_1)},$$
(23)

где $\Theta_{\text{Бр}}$ и Θ_1 — углы падения и преломления на границе раздела вакуумной среды и среды образца S , причем эти углы связаны соотношением закона преломления Снеллиуса:

$$\sin \Theta_{\text{Бр}} = n_1^* \sin \Theta_1;$$
(24)

угол падения $\Theta_{\text{Бр}}$ задан законом Брюстера:

$$\text{tg } \Theta_{\text{Бр}} = n_1, \quad (25)$$

где n_1 — действительная часть комплексного показателя преломления n_1^* среды образца S оптически одноосного кристалла,

$$n_1^* = n_1 + i\chi_1. \quad (26)$$

Здесь χ_1 — мнимая часть комплексного показателя преломления n_1^* .

Следует учитывать, что n_1^* зависит от ориентации оптической оси ζ двумерного кристалла относительно направления линейной p -поляризации падающего потока света на образец S , определяемой углом α . При азимуте $\alpha = 0$ или $\alpha = 90^\circ$ значение n_1^* равно комплексному показателю преломления n_e^* или n_o^* соответственно необыкновенной или обыкновенной световой волны, распространяющейся в среде оптически одноосного кристалла.

Используя формулы Френеля (23) для амплитудных комплексных коэффициентов отражения с учетом азимута $\alpha = 0$, получаем амплитудные коэффициенты отражения $r_{p,e}^*$ и $r_{s,o}^*$ для необыкновенной и обыкновенной световых волн в оптически одноосной кристаллической среде слоя [3, 4]:

$$\begin{aligned} r_{p,e}^* &= i \chi_{1p} \frac{n_e^2 - 1}{2n_e^3}; \\ r_{s,o}^* &= \frac{n_o^2 + 1}{n_o^2 - 1}; \\ \delta\Delta_{e,o} &= \frac{2\pi}{\lambda} \Delta n_{e,o} d. \end{aligned} \quad (27)$$

Выражения (27) получены при учете известных из опыта оценок для физических характеристик среды в виде неравенств вида

$$\chi_{1(e,o)} \ll n_{1(e,o)};$$

$$\Delta n_1 = n_{1e} - n_{1o} \ll n_{1(e,o)}.$$

Таким образом, имеется непосредственная возможность измерять в реальном времени (*in situ*) не только показатели преломления n_e и n_o необыкновенной и обыкновенной световых волн в оптически одноосном кристаллическом образовании, но и находить на основе получаемого двулучепреломления Δn толщину d такого кристалла, а

также изучать в режиме *in situ* явление линейного дихроизма и связанных с ним процессов релаксации измерением мнимой части χ_{1p} комплексного показателя преломления n_p^* для компоненты потока света с линейной *p*-поляризацией.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] Langereis E., Heil S.B.S., Knoops H.C.M., Keuning W., van de Sandem M.C.M., Kessels W.M.M. In situ spectroscopic ellipsometry as a versatile tool for studying atomic layer deposition. *J. Phys. D: Appl. Phys.*, 2009, vol. 42, 073001.
- [2] Конотопов М.В., Тебекин А.В. Концепция стратегии развития производственных технологий. *Инновации и инвестиции*, 2007, № 1 (9), с. 2–15.
- [3] Аззам Р., Башара Н. *Эллипсометрия и поляризованный свет*. Москва, Мир, 1981, 584 с.
- [4] Кирьянов А.П. *Голоэллипсометрия in situ: основы и применения*. Москва, МГУДТ, 2003, 220 с.
- [5] Харкевич А.А. *Спектры и анализ*. Москва, ГИТЛ, 1975.

Статья поступила в редакцию 24.06.2013

Ссылку на эту статью просим оформлять следующим образом:

Али М., Качурин Ю.Ю., Кирьянов А.П. Лазерная интерференционная голоэллипсометрия *in situ* с нормальным и Брюстеровским отражениями света. *Инженерный журнал: наука и инновации*, 2013, вып. 7.

URL: <http://engjournal.ru/catalog/pribor/optica/836.html>

Али Мохаммед — аспирант кафедры «Оптико-электронные приборы научных исследований» МГТУ им. Н.Э. Баумана. Автор шести публикаций. Области научных интересов: прикладная оптика, оптико-электронные приборы.

Качурин Юрий Юрьевич — старший преподаватель кафедры «Оптико-электронные приборы научных исследований» МГТУ им. Н.Э. Баумана. Автор шести публикаций в области оптотехники. e-mail: caich@mail.ru

Кирьянов Анатолий Павлович — д-р физ.-мат. наук, ведущий научный сотрудник Научно-технологического центра уникального приборостроения Российской академии наук, профессор кафедры «Оптико-электронные приборы научных исследований» МГТУ им. Н.Э. Баумана. Автор 230 публикаций. Области научных интересов: физика и техника низких температур, сверхпроводимость и эффект Джозефсона, оптика, оптотехника, эллипсометрия, нанотехнология, квантовая лингвистика, экономика и управления инженерной деятельности.